[] Docket No.: GR 97 P 1049 D

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on the date indicated below.

By: March 29, 2001

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Inventor

: Bernhard Schaetzler, et al

Applic. No.

09/688,465

Filed

October 16, 2000

Title

: Electronic Component With An Integrated Circuit Mounted On

An Island Of A Lead Frame

Examiner

: Christian Wilson -

Art Unit: 2824.0

CLAIM FOR PRIORITY

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application PCT/DE 97/00105 01/22/97, filed January 22, 1997.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

MARKUS NOLFF REG. NO. 37,006

Respectfully submitted,

Date: March 29, 2001

For Applicants

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

/sc









Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung

Aktenzeichen:

PCT/DE 97/00105

Internationaler

Anmeldetag:

22. Januar 1997

Anmelder/Inhaber:

Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung:

Elektronisches Bauelement

IPC:

H 01 L 21/48

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser internationalen Patentanmeldung.

München, den 21. März 2001

Deutsches Patent- und Markenamt

Def Präsident

Im Auftrag



ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Von	ieamt a	uszufüllen	***	• •
Internationales A	PCT/DE Aktenzeichen	97	/00	105	,
nternationales A	2 2. Jan.	1997	(22.	GI. 97)	
,	RO/DE	(Germ	teches Par nan Paten errational		

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)

·	(max. 12 Exicitor)	GR 97P1049P
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Elektronisches Bauelement		
Feld Nr. II ANMELDER		
Name und Anschrift: (Familiername, Vorname; bei juristischen Pe Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und de		Diese Person ist gleichzeitig Erfinder
Siemens Aktiengesellschaf Wittelsbacherplatz 2	t	Telefonnr.: (0 89) 41 33-28 19
D-80333 München DE		Telefaxnr.: (0 89) 41 33-18 57
		Fernschreibnr.: 52100-0 sie d
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat):	DE
		ie Vereinigten die im Zusatzfeld en von Amerika angegebenen Staaten
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (W	VEITERE) ERFINDER	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname, bei juristischen Pe Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und de		Diese Person ist:
SCHÄTZLER, Bernhard		nur Anmelder
Weidenerstr. 29 D-92694 Etzenricht	· :	Anmelder und Erfinder
D <i>E</i> 		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat):	DE
		ie Vereinigten die im Zusatzfeld en von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind	d auf einem Fortsetzungsblatt angege	eben.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VER	RTRETER; ZUSTELLANSCHRIF	Т
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worde vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender		Anwalt gemeinsamer Vertreter
Name und Anschrift: (Familiermame, Vorname; bei juristischen Pe Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der		Telefonnr.: (0 89) 41 33-28 19
Siemens AG Postfach 22 16 34		Telefaxnr.: (0 89) 41 33-18 57
D-80506 München DE	;	Fernschreibnr.: 52100-0 sie d
Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.	oder gemeinsamer Vertreter bestellt	t ist und statt dessen im obigen Feld

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER					
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und d		Diese Person ist:			
ERNST, Georg		nur Anmelder			
Haidauerstr. 13 D-93107 Thalmassing		Anmelder und Erfinder			
DE .		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat):	DE			
	mmungsstaaten mit Ausnahme nur die inigten Staaten von Amerika Staaten	Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familiermame, Vorname; bei juristischen Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und d		Diese Person ist:			
		nur Anmelder			
		Anmelder und Erfinder			
		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):				
		Vereinigten die im Zusatzfeld von Amerika angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familiername, Vorname; bei juristischen I Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und d		Diese Person ist:			
		nur Anmelder			
		Anmelder und Erfinder			
	*	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):	1 3			
	mmungsstaaten mit Ausnahme nur die nigten Staaten von Amerika Staaten	Vereinigten die im Zusatzfeld von Amerika angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen F Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und de		Diese Person ist:			
		nur Anmelder			
		Anmelder und Erfinder			
	•	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nöng.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):	1			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten					
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.					

	Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN							
	Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuz werden):							
			Patent			•		
}	Keg.	AP		IW Malas	ovi.S	n Suda	nn, SZ Swasiland, UG Uganda und jeder weitere Staat,	
	ب	**-	der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und			<i>D</i> 0000	m, 52 owasiana, oo oganaa ana jeed monoto oman,	
		EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist					
	Ø	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der					
		OA	Vertragsstaat des Europäischen Patentiibereinkommens und des PCT ist OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo					
				r OAPI ur	nd de	s PCT	ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges	
		• 1					•	
1	Natio		Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonst	iges Verfahi	ren ge			
][AL	Albanien	٠.	片	LV	Lettland	
- 1	님	AM	Armenien		님	MD	Republik Moldau	
		AT	Österreich			MG	Madagaskar	
		AU	Australien			MK	Die ehemalige jugoslawische Republik	
Ų		'AZ	Aserbaidschan				Mazedonien	
		BB	Barbados			MN	Mongolei	
		BG	Bulgarien			MW	Malawi	
		BR	Brasilien			MX	Mexiko	
		BY	Belarus			NO	Norwegen	
		CA	Kanada			NZ	Neuseeland	
ı			und LI Schweiz und Liechtenstein		\sqcap	PL	Polen	
1		CN	China		$\overline{\Box}$	PT	Portugal	
		CZ	Tschechische Republik		\exists	RO	Rumänien	
		DE	Deutschland		H	RU	Russische Föderation	
- 1	H.	DK	Dänemark			SD	Sudan	
1			•		H		•	
1		EE	Estland	•	님	SE	Schweden	
- 1	님	ES	Spanien		님	SG	Singapur	
	님	FI	Finnland		닏	SI	Slowenien	
- 1	Ц	GB	Vereinigtes Königreich		\sqcup	SK	Slowakei	
4		GE	Georgien			TJ	Tadschikistan	
		HU	Ungarn			TM	Turkmenistan	
		IL	Israel			TR	Türkei	
1		IS	Island			TT	Trinidad und Tobago	
		JP	Japan			UA	Ukraine	
-		KE	Kenia			UG	Uganda	
		KG	Kirgisistan		\boxtimes	US	Vereinigte Staaten von Amerika	
1		KР	Demokratische Volksrepublik Korea		ī			
1				•	П	UZ	Usbekistan	
1	П	KR	Republik Korea		H	VN	Vietnam	
	H	KZ,	Kasachstan		Kaste Kaste		die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines	
I			•				tents), die dem PCT nach der Veröffentlichung	
][LK.	Sri Lanka					
		LR	Liberia		(IIC)Co	FOITHUL	atts beigetreten sind:	
	님	LS	Lesotho		닏		•	
Ī	닖	LT	Litauen		Ц			
	Ш	LU	Luxemburg				· ·	
H	7.nsät	zlich z	u den ohen genonnten Restimmungen nimm	t der Anı	meld	er naci	1 Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem	
			gen Bestimmungen vor mit Ausnahme der F				1. Regel 4.5 Ausatz v auch alle anderen nach dem	
							behalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche	
							t bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom	
							eichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird,	
	und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestittigungsgehülte. Die Bestittigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen)							

Blatt Nr. 4

	NSPRUCH	Weitere Prioritätsansprüche si	nd im Zusatzieid angegeben.
	en Anmeldung(en) wird hiermit b	peansprucht:	
Staat (Anmelde- oder Bestimmungsstaat der Anmeldung)	Anmeldedatum (<i>Tag/Monat/Jahr</i>)	Aktenzeichen	Anmeldeamt (nur bei regionaler oder internationaler Anmeldung)
(1)			!
2)	,		
	,		
		i e	
Dieses Kästchen ankreuzen, werm die begla	ubigte Kopie der früheren Ammeldung von de	em Arnt ausgestellt werden soll, das für die Zw	ecke dieser internationalen Anmeldung
	nit ersucht, eine beglaubigte Abs	chrift der oben in Zeile(n) Internationalen Büro zu übermittel	n.
Feld Nr. VII INTERNATION	NALE RECHERCHENBEHÖR	DE	. *
Wahl der Internationalen Rech Recherchenbehörden für die internation	erchenbehörde (ISA) (Sind zwei o ale Recherche zuständie, ist der Name d	der mehr Internationale er Behörde arzuseben	
	ale Recherche zuständig, ist der Name d hren soll; Zweibuchstaben-Code genügt):		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Recherche soweit wie möelich auf d	, wenn eine Recherche (internationale hörde beantragt oder von ihr durch ie Ergetnüsse einer solichen früheren v, deren Übersetzung) oder des Recherchu	e Recherche, Recherche internationaler geführt worden ist und diese Behörde Recherche zu stittzen. Die Recherche enantrags zu bezeichnen.	Art oder sonstige Recherche) bere e nun ersucht wird, die internationa oder der Recherchenantrag ist dun
Staat (oder regionales Amt):	Datum (Tag /Monat/)	Jahr): Aktenzeich	nen:
Feld Nr. VIII KONTROLLIS	re		
Diese internationale Anmeldur	g umfaßt: Dieser internationale	n Anmeldung liegen die nachstehe	end angekreuzten Unterlagen bei
1. Antrag : 4	Diatter 1. Vollmac		Blatt für die Gebührenberechnung
2. Beschreibung : 8	Blatter 2. Vollmac		Gesonderte Angaben zu hinter- legten Mikroorganismen
	Blatter 3 der Unte	ung für das Fehlen 7. Ebelege(e) (durch	Sequenzprotokolle für Nucleotide und/oder Aminosäuren (Diskette)
	Blatter 4 die Zeile	nnummer von Feld 8.	Sonstige (einzeln aufführen):
	- Diatter	ennzeichnen):	*
Insgesamt : 17	Blätter	**	
Abbildung Nr. 3 der Zeic	hnungen (falls vorhanden) soll mi	t der Zusammenfassung veröffentl	icht werden.
Feld Nr. IX UNTERSCHRII	T DES ANMELDERS ODER I	DES ANWALTS	
Der Name jeder unterzeichnenden Per ergibt, in welcher Eigenschaft die Pers Siemens Aktiengesellschaft		rholen, und es ist anzugeben, sofern sic	ch dies nicht eindeutig aus dem Antra
`.	Bernhard Schā	tzler	
Ma. Emmi			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) (Epping Vr. 144/74 Ang-AV	Georg Ernst		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		amt auszufüllen	
. Datum des tatsächlichen Einga internationalen Anmeldung:		7:	2. 01. 97) 2. Zeichnunge einge-
Geändertes Eingangsdatum auf fristgerecht eingegangener Unt			gangen: nicht ein-
	ternationalen Anmeldung:		gegangen:
	ings der angeforderten		
. Datum des fristgerechten Einga Richtigstellungen nach Artikel			
. Datum des fristgerechten Einga	11(2) PCT:		des Recherchenexemplars bis zu echerchengebühr aufgeschoben

Blatt Nr. 4

Feld Nr. VI PRIORITÄTSA	NSPRUCH	Weitere Prioritätsansprüche sin	nd im Zusatzfeld angegeben.	
Die Priorität der folgenden früher	en Anmeldung(en) wird hiermit b	eansprucht:		
Staat (Armelde- oder Bestimmingsstaat der Armeldung)	Anmeldedatum (<i>Tag/Monat/Jahr</i>)	Aktenzeichen	Anmeldeamt (nur bei regionaler oder internationaler Armeldung)	
(1)				
(2)				
(3)				
	ubigte Kopie der früheren Armeidung von de verden): nit ersucht, eine beglaubigte Abso eldung(en) zu erstellen und dem I	hrift der oben in Zeile(n)		
Feld Nr. VII INTERNATION	IALE RECHERCHENBEHÖRI	DE .		
Wahl der Internationalen Rech Recherchenbehörden für die internation die die internationale Recherche durchfür	ile Recherche zuständie, ist der Name de	er mehr Internationale ir Behörde araugeben, ISA/ EP		
Frühere Recherche: Auszeitlen bei der internationalen Recherchenbei Recherche soweit wie möglich auf di Angabe der betreffenden Anmeldung (box	wenn eine Recherche (internationale	Recherche, Recherche internationaler eführt worden ist und diese Behörde Recherche zu stützen. Die Recherche nantrags zu bezeichnen.	Art oder sonstige Recherche) bereit nun ersucht wird, die international oder der Recherchenantrug ist durch	
Staat (oder regionales Amt):	Datum (Tag/Monat/Jo		•	
Feld Nr. VIII KONTROLLIST	TE		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Diese internationale Anmeldun	g umfaßt: Dieser internationaler	Anmeldung liegen die nachsteher	nd angekreuzten Unterlagen bei:	
2. Beschreibung : 8 3. Ansprüche : 3	Blätter 2. Vollmach Kopie der Vollmach Blätter 3. Begründt der Unter	allgemeinen t ng für das Fehlen schrift elege(e) (durch	Blatt für die Gebührenberechnung Gesonderte Angaben zu hinter- legten Mikroorganismen Sequenzprotokolle für Nucleotide und/oder Aminosäuren (Diskene)	
5. Zeichnungen : 1	ale Zellen	nummer von Feld 8 unzeichnen):	Sonstige (einzeln aufführen):	
Abbildung Nr. 3 der Zeich	nungen (falls vorhanden) soll mit	der Zusammenfassung veröffentlic	cht werden.	
Feld Nr. IX UNTERSCHRIF	T DES ANMELDERS ODER D	ES ANWALTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindendig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. Siemens Aktiengesellschaft				
	Bernhard Schät	zler		
Mr. Epping Nr. 144/74 Ang-AV	Corg Ernst	<i>\f</i>		
. Datum des tatsächlichen Eingan	Wom Anmeldear		2 os 07 2/ Zeichnungen	
internationalen Anmeldung: 3. Geändertes Eingangsdatum aufg	rund nachträglich, jedoch	2 2. Jan. 1997 (2.1	2. 01. 97	
fristgerecht eingegangener Unte zur Vervollständigung dieser int Datum des fristgerechten Eingar	ernationalen Anmeldung:	· .	nicht ein- gegangen:	
Richtigstellungen nach Artikel I Vom Anmelder benannte		6. — Übermittlung de	s Dacherchenevernalous his sur	
Internationale Recherchenbehöre		Zahlung der Rec	s Recherchenexemplars bis zur herchengebühr aufgeschoben	
Datum des Einganges des Aktenexe	Vom Internationalen	Büro auszufüllen		

Beschreibung

Elektronisches Bauelement

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauelement, insbesondere dünne QFPs, bei dem ein standardisierter Zuleitungsrahmen und ein integrierter Schaltkreis verwendet und in eine Gieß- oder Preßmasse eingebettet werden.

Oberflächenmontierte elektronische Bauelemente, auch SMD-Bau-10 elemente genannt, werden üblicherweise in ein Gehäuse aus einer Kunststoffpreßmasse eingebettet, aus dem die elektronischen Anschlüsse herausgeführt werden. Je nach Anzahl der benötigten Anschlüsse entsprechen diese Gehäuse einer Norm mit festgelegten Abmessungen, um so eine standardisierte Herstel-15 lung und automatische Bestückung von Platinen zu ermöglichen. Die Abmessungen dieser Gehäuse sind in deutschen und internationalen Normen festgelegt. Die Zuleitungsrahmen (Leadframes), die zur exakt positionierten Einbettung der elektrischen Anschlüsse verwendet werden, sind ebenfalls stan-20 dardisiert. In der Mitte dieser Zuleitungsrahmen sind Inseln vorgesehen, auf denen die integrierten Schaltkreise befestigt werden. Zuleitungsrahmen und integrierter Schaltkreis werden dann zusammen in dem Gehäuse aus Preßmasse eingepreßt. Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Eisen/Nickel-Legierung, die üblicherweise für den Zuleitungsrahmen verwendet wird, des Silizium-Chips, der den integrierten Schaltkreis bildet, und der Preßmasse des Gehäuses und dem außerdem noch auftretenden Reaktionsschrumpf der 30 Preßmasse kommt es zu Spannungen. Dadurch kommt es insbesondere bei großen flachen Gehäusen (dünne QFPs, auch TQFPs genannt) zu diagonalen Gehäuseverwölbungen von bis zu 100 µm.

Man versucht diese Gehäusedurchbiegung oder Wölbung, auch Warpage genannt, durch Verwendung von speziellen Inseldesigns zu unterbinden. Dabei werden in die Inseln, die zentral in den Zuleitungsrahmen (Leadframes) angeordnet sind,

Löcher oder Schlitze angebracht oder die Inseln unterätzt oder Riefen in die Inseln eingeätzt. Auch die Verwendung von Kupferzuleitungsrahmen ist schon versucht worden, um die Gehäuseverwölbung zu minimieren. All diese Lösungen erfordern jedoch entweder neue oder geänderte Montageprozesse, oder sie sind nur mit geätzten und nicht mit gestanzten Leadframes durchführbar, oder sie führen zu einer Reduzierung der Steifigkeit der Außenanschlüsse.

5

20

30

35

10 Aus der DE 36 35 375 Al ist die Verwendung eines standardisierten Zuleitungsrahmen bekannt. Hierbei wird zur Anpassung der Trägerinsel an das Halbleiterbauelement eine entsprechende Trägerinsel auf dem Mittelteil des Rahmens befestigt.

15 Um Verbiegungen eines umgossenen Elements zu vermeiden ist aus der EP 0261324 Al bekannt, den Leiterrahmen höhenmäßig zentriert in der Vergußform anzuordnen, damit oberhalb und unterhalb des integrierten Schaltkreises gleichviel Kunststoff gelangt.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein elektronisches Bauelement der eingangs genannten Art zu schaffen, welches auf konstruktiv einfache Weise die Gehäusedurchbiegung minimiert.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt verfahrensmäßig gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 und vorrichtungsmäßig gemäß den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 5. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.

Nach dem Grundgedanken der Erfindung wird bei dem Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements ein standardisierter Zuleitungsrahmen mit einer vorgegebenen Anzahl von Zuleitungen und einer zentralen Insel zur Aufnahme eines integrierten Schaltkreises verwendet, wobei jeder Zuleitungsrahmen für eine Gruppe von verschieden großen integrierten Schaltkreisen geeignet ist. Die Insel wird dann auf eine

Größe reduziert, die im wesentlichen der Größe des jeweils verwendeten integrierten Schaltkreises angepaßt ist. Anschließend wird der Zuleitungsrahmen mit dem darauf befestigten integrierten Schaltkreis in eine Gieß- oder Preßmasse eingebettet und diese wird so zentriert, daß oberhalb des Schaltkreises und unterhalb der Insel jeweils gleich viel Preßmasse vorhanden ist. Ein Überstand der Insel über die Grundfläche des integrierten Schaltkreises, durch den eine Asymmetrie in der Preßmassenverteilung entstehen würde, wird dabei weitestgehend vermieden. Durch diese Ausbildung wird erreicht, daß beim auftretenden Reaktionsschrumpf der Preßmasse am Umfang des integrierten Schaltkreises zwischen dessen Rand und dem Inselrand keine Spannungen auftreten, die zu einer Gehäuseverwölbung führen.

15

10

Bevorzugt wird der Zuleitungsrahmen mit der darin einstückig ausgebildeten Insel gestanzt, um die Insel auf die erwünschte Größe zu bringen. Alternativ ist auch die Bearbeitung des Zuleitungsrahmens und der Insel mit Ätzprozessen möglich.

20

30

35

Die Anpassung der Insel findet günstigerweise nach Herstellung der Standardleadframes statt, weil dann weiterhin nur ein kompletter standardisierter Zuleitungsrahmen verwendet werden muß. Andererseits kann die Größenanpassung der Insel auch bereits in den Herstellungsprozeß des Zuleitungsrahmens integriert werden, wobei dann jedoch verschiedene angepaßte Zuleitungsrahmen mit Inselgrößen, die an die jeweilige Größe des integrierten Schaltkreises angepaßt sind, hergestellt werden müssen. Die Werkzeuge zur Herstellung des Zuleitungsrahmens sind modular aufgebaut, um eine Anpassung der Inselgröße einfach durchführen zu können.

Üblicherweise wird die Insel auf eine Größe reduziert, die etwas größer als die des integrierten Schaltkreises ist. Der integrierte Schaltkreis wird nämlich bevorzugt durch Kleben mit einem Silberleitkleber auf der Insel befestigt. Der dann zwischen integriertem Schaltkreis und Insel hervortretende

Kleber wird kontrolliert und dient als Maß für eine korrekte Befestigung. Im Bereich des Inselüberstands bildet sich eine Hohlkehle aus, die optisch gut zu kontrollieren ist.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird ein elektronisches Bauelement mit einem integrierten Schaltkreis und einem standardisierten Gehäuse aus Gieß- oder Preßmasse, in welches der integrierte Schaltkreis eingebettet ist, und mit einem Zuleitungsrahmen, der eine zentrale Insel zur Aufnahme des integrierten Schaltkreises aufweist, hergestellt. Dieses elektronische Bauelement zeichnet sich dadurch aus, daß die Insel im wesentlichen bündig mit dem integrierten Schaltkreis abschließt, und daß der Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses und dem integrierten Schaltkreis dem Abstand zwischen der Unterseite des Gehäuses und der Insel entspricht. Falls die Insel größer als der darauf befestigte integrierte Schaltkreis ist, so ergeben sich im Bereich des Inselüberstandes eine unterschiedliche Preßmassendicke zwischen der Inseloberseite und der Gehäuseoberseite einerseits und der Inselunterseite und der Gehäuseunterseite andererseits. Dieser Dickenunterschied verursacht im Zusammenwirken mit dem steifen Zuleitungsrahmen aus einer speziellen Metallegierung Spannungen in dem Gehäuse, die sich in der Gehäuseverwölbung auswirken.

10

15

20

35

Allein das Verhältnis von der Grundfläche des integrierten Schaltkreises zur Inselfläche bestimmt bei sonst gleichen Materialien, Fertigungsequipment, Prozessen und Prozeßparametern den Grad der Gehäuseverwölbung. Durch die Anpassung der Inselgröße an die jeweilige Grundfläche des integrierten Schaltkreises werden die Spannungen zwischen integriertem Schaltkreis, Zuleitungsrahmen und Preßmasse so ausbalanciert, daß die Gehäuseverwölbung je nach Verhältnis der Flächen zueinander reduziert oder beseitigt wird.

Um zu einer besonders guten Minimierung der Gehäusewölbung zu gelangen, wird die Insel bündig abschließend mit dem aufge-

brachten integrierten Schaltkreis ausgebildet. Insel und integrierter Schaltkreis weisen dann also exakt die gleiche Größe auf. Dadurch sind an allen Stellen im Gehäuse die Preßmassendicken zwischen der Oberseite des integrierten Schaltkreises und dem oberen Gehäuserand und der Unterseite der Insel und dem unteren Gehäuserand gleich groß und die Spannungen kompensieren sich gegenseitig. Der Bimetall-Effekt, der sich durch die verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten ergibt, wird durch den symmetrischen Aufbau vermieden.

10

15

20

5

In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung kann es vorteilhaft sein, die Insel etwas größer als den integrierten Schaltkreis auszubilden, wobei der integrierte Schaltkreis auf die Insel aufgeklebt wird und der austretende Kleber dann auf dem überstehenden Inselrand eine Hohlkehle bildet, mit deren Ausbildung kontrolliert werden kann, ob der integrierte Schaltkreis korrekt auf der Insel verklebt ist. Besonders günstig ist es dabei, die Insel so auszubilden, daß das Verhältnis von der Grundfläche des integrierten Schaltkreises zu der Insel kleiner 0,9: 1 beträgt.

Die Insel ist in der vorliegenden Erfindung als durchgehende, unstrukturierte Fläche ausgebildet. Dadurch wird sichergestellt, daß die Dicke der Preßmasse oberhalb und unterhalb des integrierten Schaltkreises und der Insel gleich groß ist. Außerdem entfallen die im Stand der Technik vorgesehenen Strukturierungen und speziellen Designs der Insel.

30

In einer anderen Ausführungsform der Erfindung können die Zuleitungen bis an die Insel herangeführt ausgebildet sein. Dies ist insbesondere bei sehr kleinen integrierten Schaltkreisen vorteilhaft, bei denen sonst ein zu großer Abstand von den Zuleitungen bis zur Insel entstehen würde und Probleme bei der weiteren Kontaktierung auftreten könnten. Nachfolgend werden verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung weiter erläutert. Im einzelnen zeigen die schematischen Darstellungen in:

- 5 Figur 1 eine seitliche Schnittansicht eines erfindungsgemäßen Bauelements mit großem integrierten Schaltkreis;
 - Figur 2 eine seitliche Schnittansicht durch ein erfindungsgemäßes Bauelement mit einem kleinen integrierten Schaltkreis; und

10

15

20

30

35

Figur 3 eine seitliche Schnittansicht durch ein erfindungsgemäßes Bauelement mit einem kleinen integrierten Schaltkreis und bündig abschließender Insel.

In Figur 1 ist ein Querschnitt durch ein elektronisches Bauelement dargestellt, in dem ein Zuleitungsrahmen 2 verwendet wird, der insbesondere aus den Zuleitungen 3 und einer Insel 4 besteht. Auf der Insel 4 wird ein integrierter Schaltkreis 1 befestigt und Zuleitungsrahmen 2 und integrierter Schaltkreis 1 dann in ein Gehäuse 6 aus Preßmasse eingebettet. Dabei wird der Schaltkreis 1 und die Insel 4 höhenmäßig so angeordnet, daß Gehäusebereiche 7 und 8 entstehen, die jeweils eine Dicke a und b aufweisen, die gleich groß sind. Dabei ist erfindungsgemäß die Größe der Insel 4 der Grundfläche des integrierten Schaltkreises 1 angepaßt worden, so daß diese im wesentlichen übereinstimmen. Die Insel 4 ist lediglich um einen kleinen Überstand größer als die Grundfläche des integrierten Schaltkreises 1, so daß der zum Befestigen des integrierten Schaltkreises 1 auf der Insel 4 verwendete Klebstoff ausweichen kann und auf dem Überstand eine Hohlkehle 5 bildet. Diese Hohlkehle 5 bildet einen geeigneten Kontrollparameter zur Überwachung einer optimalen Verklebung des integrierten Schaltkreises 1 mit der Insel 4. Der Gesamtzuleitungsrahmen 2 ist höhenmäßig so angeordnet, daß die Zuleitungen 3 ebenfalls zentriert in dem Gehäuse 6 angeordnet sind.

Oberhalb und unterhalb der Zuleitungen erstrecken sich also Gehäusebereiche mit gleicher Dicke, die in der Figur mit c bezeichnet ist. Die Insel 4 ist also gegenüber den Zuleitungen 3 erfindungsgemäß abgesenkt und zwar in einer der Höhe des integrierten Schaltkreises 1 angepaßten Weise. Diese höhenmäßige Anpassung ist bei der Herstellung des Zuleitungsrahmens 2 und der Verbindungen zwischen den Zuleitungen 3 und der Insel 4 zu berücksichtigen.

In Figur 2 ist ein erfindungsgemäßes elektronisches Bauelement mit einem kleinen integrierten Schaltkreis 11 dargestellt. Dazu wird die Insel 14 entsprechend dem kleineren integrierten Schaltkreis 11 angepaßt und dementsprechend kleiner ausgebildet. Ein geeignetes Verhältnis der Grundfläche
des integrierten Schaltkreises 11 zur Insel 14 liegt, wie
Tabelle I zu entnehmen ist zwischen 0,7 und 0,9.

In Versuchen mit verschiedenen TQFP 20 \times 20 \times 1,4 mm - Gehäusen, Alloy42 Leadframe und Preßmasse Aratronic 2188 wurden folgende Zusammenhänge ermittelt.

Inselgröße	Verhältnis Chip-	Gehāuseverwōlbung
in mm x mm	fläche/Inselfläche	diagonal (Mittelwert)
•		
13,8 x 13,8	0,7	′ < 80µm
13.8×13.8	0,8	< 60µm
13,8 x 13,8	0,9	< 20µm
		*
11,6 x 11,6	0,6	> 70µm
$9,4 \times 9,4$	0,6	> 80µm
$9,4 \times 9,4$	0,9	< 30µm

Die Insel 14 ist innerhalb des Zuleitungsrahmens 2 gegenüber den Zuleitungen 3 so abgesenkt, daß sowohl oberhalb und unterhalb der Zuleitungen 3 Gehäusebereiche mit gleicher Dicke c entstehen und auch oberhalb und unterhalb des

25

integrierten Schaltkreises 11 und der Insel 14
Gehäusebereiche 7 mit der Dicke a und Gehäusebereiche 8 mit
der Dicke b entstehen, wobei a = b gilt. Auch in diesem
Ausführungsbeispiel wird ein geringer Überstand der Insel 14,
an dem infolge des Reaktionsschrumpfes der Preßmasse
Spannungen auftreten, in Kauf genommen, um auf diesem
Inselüberstand eine Hohlkehle 5 erzeugen zu können, die ein
wichtiger Kontrollparameter bei der Herstellung ist.

10 Eine andere Ausführungsform der Erfindung ist in Figur 3 dargestellt, in der ebenfalls ein kleiner integrierter Schaltkreis 11 mit einer bündig abschließenden Insel 24 dargestellt
ist. In diesem Beispiel sind überhaupt keine überstehenden
Inselbereiche vorhanden, an denen Spannungen infolge des
15 Reaktionsschrumpfes der Preßmasse auftreten könnten.

20

30

In den Figuren sind lediglich integrierte Schaltkreise 1 und 11 mit zwei verschiedenen Größen dargestellt. Es versteht sich jedoch, daß für ein standardisiertes und genormtes Gehäuse 6 eine ganze Gruppe von integrierten Schaltkreisen mit unterschiedlichen Größen zum Einsatz kommt. Entsprechend der Größe der Grundfläche des integrierten Schaltkreises wird die Insel größenmäßig angepaßt, so daß der Standardzuleitungsrahmen erfindungsgemäß weiterverarbeitet wird und für eine ganze Gruppe unterschiedlicher integrierter Schaltkreise einsetzbar ist, ohne daß es zu einer Gehäuseverwölbung kommen würde. Bei den vorstehend beschriebenen Gehäusen handelt es sich um große dünne quadratische Gehäuse, sog. TQFPs, mit beispielsweise 176 Zuleitungen, die an allen vier Seiten aus dem quadratischen Gehäuse herausgeführt werden.

Patentansprüche

5

20

30

35

- 1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere einen dunnes QFPs, bei dem
- ein standardisierter Zuleitungsrahmen (2) mit einer vorgegebenen Anzahl von Zuleitungen (3) für eine Gruppe von verschieden großen integrierten Schaltkreisen (1, 11) hergestellt wird, wobei der standardisierte Zuleitungsrahmen (2)

 mit einer zentralen Insel (4, 14, 24) vorgegebener maximaler
 Größe zur Aufnahme von einem der integrierten Schaltkreise
 (1, 11) aus dieser Gruppe ausgebildet wird,
- die Insel (4, 14, 24) entsprechend der Grundfläche des je-15 weils verwendeten integrierten Schaltkreises (1, 11) auf ein geeignetes Größenverhältnis verkleinert wird,
 - der integrierte Schaltkreis (1, 11) auf der Insel (4, 14, 24) befestigt wird, und
 - der Zuleitungsrahmen (2) mit dem auf der Insel (4, 14, 24) befestigten integrierten Schaltkreis (1, 11) in eine Gieß- oder Preßmasse eingebettet wird, wobei die Einheit aus Insel und integriertem Schaltkreis höhenmäßig zentriert wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch g e k e n n z e i c h n e t,
 daß der Zuleitungsrahmen mit der darin ausgebildeten Insel
 (4, 14, 24) gestanzt wird.
 - 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich net, daß der integrierte Schaltkreis (1, 11) auf die Insel (4, 14, 24) aufgeklebt wird.
 - 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

daß die Befestigung des integrierten Schaltkreises (1, 11) auf der Insel (4, 14, 24) anhand heraustretenden Klebers kontrolliert wird.

- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich net, daß das geeignete Größenverhältnis zwischen 0,7 und 0,9 liegt.
- 10 6. Elektronisches Bauelement mit einem integrierten Schaltkreis (1, 11) und einem standardisierten Gehäuse (6) aus Gieß- oder Preßmasse, in welches der integrierte Schaltkreis (1, 11) eingebettet ist, und mit einem Zuleitungsrahmen (2), der eine zentrale Insel (4, 14, 24) zur Aufnahme des integrierten Schaltkreises aufweist, wobei die Insel so ausgebil-15 det ist, daß eine Gehäusedurchbiegung vermieden wird, dadurch gekennzeichnet, daß die İnsel (4, 14, 24) im wesentlichen bündig abschließend mit dem integrierten Schaltkreis (1, 11) ausgebildet ist, und 20 daß die Dicke des Gehäusebereiches (7) oberhalb des integrierten Schaltkreises (1, 11) gleich der Dicke des Gehäusebereiches (8) unterhalb der Insel (4, 14, 24) ist.
 - 7. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Insel (4, 14) etwas größer als der Chip (1, 11) ist.
 - 8. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
- 30 dadurch gekennzeichnet,
 daß der integrierte Schaltkreis (1, 11) auf die Insel (4, 14)
 aufgeklebt ist und der ausgetretene Klebstoff am integrierten
 Schaltkreis (1, 11) eine Hohlkehle (5) bildet.
- 9. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

daß das Verhāltnis der Grundfläche des integrierten Schaltkreises zur Inselfläche kleiner 0,9 : 1 beträgt.

10. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Werhältnis der Grundfläche des integrierten
Schaltkreises zur Inselfläche im Bereich 0,9 - 0,7 liegt.

10 11. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 6 bis 10,

15

dadurch gekennzeichnet, daß die Insel (4, 14, 24) als durchgehende, unstrukturierte Fläche ausgebildet ist.

12. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 6
bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Zuleitungen (3) bis an die Insel (4, 14, 24) herange20 führt ausgebildet sind.

13. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 6 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, daß die Zuleitungen (3) höhenmäßig zentriert in dem Gehäuse (6) angeordnet sind und die Insel (4, 14, 24) gegenüber den Zuleitungen (3) etwas abgesenkt ist. Zusammenfassung

Elektronisches Bauelement

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauelement, bei dem ein Standardzuleitungsrahmen verwendet wird, dessen zur Aufnahme eines integrierten Schaltkreises geeignete Insel größenmäßig an die Grundfläche des integrierten Schaltkreises angepaßt wird, um auf diese Weise Gehäuseverbiegungen zu minimieren und zu verhindern.

Figur 3





